	13	Формат	Зона	Поз.	Обозна чение	Наименование	Кол.	Приме- чание
примен.	PEYH. 94 16 13.002	*)			РЕУН.468172.001 СБ 2D	<u>Документация</u> Сборочный чертеж		*)ЛД,А2
Перв. пр	PEYH.94	*)			PEYH.468172.001 33 2D	Схема электрическая принципиальная		*)// <u>//</u> ,A3,A4
		*/			РЕУН.468172.001 ПЭЗ ТЭ	Перечень элементов		*)//Д,А4
~		*)			РЕУН.468172.001 ВП ТЭ	Ведомость покупных изделий		*)// <u>//</u> ,A3,A4
Справ. 1						<u>Сборочные единицы</u>		
		*)		2	РЕУН.687253.001 ТЭ	Плата печатная	1	* <i>\ЛД</i> ,A4
						Прочие изделия		
Подп. и дата						Конденсаторы фирма Кетеt,США		
Инв. И дубл.				6		C1210C475K5RACTU	4	C17-C19,
Взам. инв. И				8		C1210C476M4PACTU	2	C30, C31
Инв. Иподл. Подп. и дата В		Ра: П <u>І</u> Н.к	у Ли Зраз гов.	δ. [7] <u> </u> np.	N докум. Подп. Дата Годлесный подп. 10.06.22 Гавликов подп. 10.06.22 Гавликов подп. 10.06.22	айвер лазера	<u>Лист</u> 1	Листов 9

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			10		Конденсатор 08055D105KAT2A	2	C21, C25
					фирма Kyocera AVX, США		
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
			13		CC0603KRX7R9BB102	1	C16
			15		CC0603KPX7R9BB472	1	С23
			17		CC0603KRX7R9BB103	1	<i>C20</i>
dama			19		CC0603KRX7R9BB333	1	С27
Nodn. u			21		CC0603KRX7R9BB104	11	<u>C1-C7,C24</u>
Инв. N дубл.							C28,C29, C32
Взам. инв. N			23		CC0603ZRY5V9BB224	1	C26
			25		CC0603KRX7R7BB105	6	<u>C9-C14</u>
Подп. и дата					CC4004WWEDODD404	4	50
Jh.	\vdash		<i>2</i> 7		CC1206KKX5R8BB106	1	<u>C8</u>
Инв.И подл.	Изм	1. //	ист.	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468172.001 T Э		Auc.

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Конденсаторы фирма Panasonic, Япония		
			28		EEHZC1H101P	1	<i>C15</i>
			30		EEE-FP1A221AP	2	C33,C34
			32		Muunnesvaug V700F F00D7	1	DA2
			JZ		Микросхема K7805-500R3 фирма Mornsun Power, Китай		DAZ
			34		Микросхема LT3741EFE#PBF	1	DA4
					фирма Analog Devices,США		
Подп. и дата					Микросхемы фирма Texas Instruments, США		
. N дубл.			37		INA 199A 1DCKT	1	DA3
N MHB.			<i>39</i>		LMV321IDBVT	1	DA5
Взам. инв. N			41		TI I/702ZZNRI/T	1	DA1
і дата			71		TL V 70233DB V T		DA I
Подп. и дата			43		MAX232ID	1	DD2
Инв.И подл.					DEUD / 40172 001 T		Лис
NH.	Изм	ı. /Iu	ст	N°докум. Подп. Дата Копирова	PEYH.468172.001 T.5 111		3

1		Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол	Приме- чание
фирма Техая Instruments, CIIIA 48									
фирма Техая Instruments, CIIIA 48				1.6			CN7/ LVC4CZ4F7DDVD	1	חחק
1 48				40				/	טטט
Дер нер нер нер нер нер нер нер нер нер н							фирма Texus Instruments, США		
Дер нер нер нер нер нер нер нер нер нер н									
Ден на при				48				1	<i>DD1</i>
В 51							фирма ST Microelectronics, Швейцария		
Дер и до нед и до не							Светодиоды фирма Kingbright, Taußань		
ВИВО Л 400							11 5 .		
1 54 Ферриповая бусина BLM18TG102TN10 1 L1 фирма Murata Manufacturing, США 56 Катушка индуктивности 7443551130 1 L2 фирма Wurth Elektronik, Германия 58 Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yageo, Тайвань 1 Изм. Лист № докум. Подп. Дата				51			APT1608CGCK	1	HL1
1 54 Ферриповая бусина BLM18TG102TN10 1 L1 фирма Murata Manufacturing, США 56 Катушка индуктивности 7443551130 1 L2 фирма Wurth Elektronik, Германия 58 Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yageo, Тайвань 1 Изм. Лист № докум. Подп. Дата									
1 54 Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D 1 L1	ата			53			APT1608EC	1	HL2
Ферритовая бусина BLM18161021M10 1 L1 фирма Murata Manufacturing, США 56 Катушка индуктивности 7443551130 1 L2 фирма Wurth Elektronik, Германия 58 Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yaqeo, Тайвань РЕУН. 468172.001 ТЭ									
ры учи		┡		54				7	L 1
1 56 Катушка индуктивности 7443551130 1 L2 фирма Wurth Elektronik, Германия 1 58 Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yageo, Тайвань 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N дубл.						Фирма Murata Manutacturing, LША		
фирма Wurth Elektronik, Германия 58 Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yaqeo, Тайвань РЕУН. 468172.001 ТЭ Лим. Лист № докум. Подп. Дата		L							
Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yaqeo, Тайвань РЕУН. 468172.001 ТЭ	>			56				/	LZ
Резисторы RC0603FR-070RL 1 R12 фирма Yageo, Тайвань РЕУН. 468172.001 ТЭ Лита Подп. Дата	зам. инв						Фирма Wurth Elektronik,I ермания		
РЕ УН. 468172.001 ТЭ Изм. Лист N°докум. Подп. Дата	<u>8</u>	\vdash							
РЕ УЗМ. Лист N°докум. Подп. Дата РЕУН. 468172.001 ТЭ	и дата			58			Резисторы RCO6O3FR-070RL	1	R12
ИЗМ, ЛИСТ N ООКУМ. 110011. ДАПА	Nodn.						фирма Үадео, Тайвань		
ИЗМ, ЛИСТ N ООКУМ. ПООП. ДОТО	одл.								
	MHB.N n.	Изм	PEYH. 468172.001 T						

финист	Зона	हैं Обозначени		начение	Наименование	кол	Приме- чание	
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань			
	╀	\vdash						
F	F	61			RC0603FR-0710RL	2	R13,R14	
F	F	63			RC0603FR-071KL	2	R2,R4	
F	F				REDUDJI R-D7 INL		K2,K4	
		65			RC0603FR-079K1L	1	R18	
		67			RC0603FR-0710KL	2	R1,R17	
-		69			RC0603FR-0711KL	1	R19	
	F	71			RC0603FR-0745K3L	1	R7	
		73			RT0603DRD0765K5L	1	R11	
		75			RC0603FR-07100KL	3	R3,R9,R10	
╁								
F	L	77			RC0603FR-07120KL	1	R6	
上	L	79			RC0603FR-07360KL	1	R5	
F	<u> </u>	H			 PEYH.468172.001 T3	<u> </u>	10	
Из	m. /l	CM	N°докум. По	дп. Дата	T L JTT.400172.00112			

	Формат	Зона	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			88		Резисторы RC0603FR-07680KL	1	R8
					фирма Үадео, Тайвань	-	
						+	
			90		Резистор CRCW2512100KFKEG	2	R15, R16
					фирма Vishay,США		
						+	-
			92		Потенциометр 3224W-1-103E	1	RP1
					фирма Bourns,CШA		
						_	
						+	
7			94		Стабилитрон BZT52C3V3S-7-F	1	VD2
и дата					фирма Diodes Incorporated, США		
Nodn						+	
.ï.	_						
N дубл.			96		Диод MBRA340T3G	2	VD4, VD5
NHÔ.					фирма ON Semiconductor, США	+	
Ø. N							
Взам. инв.							
188	_		98		Диод РМЕG6010CEH	2	VD3, VD6
ата					фирма NXP Semiconductors,Китай	_	
Подп. и дата						+	
710							
подл.			ı				
Инв.N подл.		1 2	+	M°20, m	PEYH.468172.001 T3	7	/lu
-	N3M	1. /IU	כוח	N°докум. Подп. Дата		ıam A4	

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			102		Aug. SMA 121.CA FZ /61	1	VD1
			102		Диод SMAJ24CA-E3/61 фирма Vishay Semiconductors,США	,	VDT
					Транзисторы фирма Infineon		
					Technologies Corporation, Германия		
			104		BSC011N03LSI	1	VT2
			106		DSCOONIOZI S C	1	VT3
			100		BSC080N03LS G	/	VIJ
a							
и даша			108		Транзистор FDD6637	1	VT1
llodn. u					фирма ON Semiconductor		
yov.							
ő. N dyön.	Н						
NHO	\vdash		111		Вилка L-KLS1-207C-2.50-2-10-S	1	X1
N JHQ					фирма KLS Electronic, Китай		IPLLD1.27-1
Взам. инб. N							
	H						
llodn. u dama							
llodn.			113		Вилка 87834-0819	1	X4
7	+				фирма Molex,США		
Инб.И подл.			7)	<u>/luc</u>
H H	Изм	. /Iu		N°докум. Подп. Дата	PEYH.468172.001 T.J TUDOBAN PODMA		7

	Формат	Зона	Поз.	Обозначен	iue		Наименование		Кол	Приме- чание
			116				Клемма РСВ7М3		4	X2,X3,X5,
							фирма Yuansichuang, Kumaū			Х6
П	+									
дата										
Подп. и д										
Ποσ										
удул.	_									
Инв. И дубл.										
× ×	+									
лнв. И										
Взам. инв. N	\vdash									
	$ begin{array}{c} - \end{array}$									
Подп. и дата	\vdash									
Подп. ц										
	_									
Инв.N подл.		Н	lacksquare	<u> </u>	<u> </u>					Лист
NH0.N	Изм	1. /lu	<u>cm</u>	N°докум. Подп.	Дата	PE	YH.468172.001	ТЭ		8
	1.707	,				Копировал		Формал	n A4	

				Лист рег	гистрации	изменений			
Изм.	НОМ ИЗМЕНЕН- НЫХ	лера листов заменен- ных	д (страниц) новых	анулиро- ванных	Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	Подпись	Дата
					,		<u>dama</u>		
+									
+									
H									
F									Лист
Изм	Лист N до	кум. Поді	п. Дата	F	PEYH.4	68172.0	001 T 3		9
71317.	יוטבווון וזיטט	<u>ngri. 11001</u>	<u>. [дини]</u>	Копировал			Формат А	14	